1

Hoofdstuk 1: Transistorschakelingen: oefeningen

- 1: De GES, GBS of GCS met een praktische bron en een praktische belasting
 - 1.1: De GES
 - 1.2: De GBS
 - 1.3: De GCS
 - 1.4: Oefening 1
 - 1.5: Oefening 2
 - 1.6: Belangrijke opmerkingen bij GCS
- 2: De tweetrapsversterker met AC of DC koppeling
 - 2.1: De AC-gekoppelde versterker
 - 2.2: De DC-gekoppelde versterker
 - 2.3: De DC-gekoppelde versterker: opmerkingen
 - 2.4: Oefening
- 3: De GES met stroomtegenkoppeling
 - 3.1: Opmerkingen 1
 - 3.2: Opmerkingen 2
 - 3.3: Oefening
- 4: De emittervolger met bootstrap
 - 4.1: Voorbeeld
 - 4.2: Opmerkingen
- 5: Extra opmerkingen bij transistorschakelingen

Hoofdstuk 2: De veldeffecttransistor

1: De JFET

- 1.1: De N-kanaal JFET
- 1.2: De P-kanaal JFET
- 1.3: Opgaven en geleide oefeningen
- 2: De karakteristieken van de JFET
 - 2.1: De uitgangskarakteristiek
 - 2.2: De transfertkarakterisitiek
 - 2.3: De drainstroom
 - 2.4: Opmerkingen en opgaven
- 3: De unipolaire JFET versus de bipolaire transistor
- 4: De symmetrische JFET-structuur
 - 4.1: Opgave
- 5: Grenswaarden en karakteristieke grootheden
 - 5.1: De grenswaarden
 - 5.2: De steilheid of transfertadmittantie
 - 5.3: De uitgangsadmittantie
 - 5.4: Opmerkingen

Hoofdstuk 3: JFET-versterkerschakelingen

- 1: Inleiding
- 2: De DC-instelling
 - 2.1: DC-instelschakeling 1
 - 2.2: DC-instelschakeling 2

- 2.3: DC-instelschakeling 3
- 2.4: Oefeningen
- 2.5: DC-instelschakeling 4
- 2.6: Geleide oefening
- 2.7: De temperatuursinvloed
- 3: Het gebruik van de JFET versus de bipolaire transistor
- 4: De AC-versterking met behulp van een JFET-schakeling
 - 4.1: De AC-versterking
- 5: De GSS, de GGS en de GDS
 - 5.1: De fundamentele schakelingen
 - 5.2: Analogie tussen JFET en bipolaire transistor
- 6: De gemeenschappelijke sourceschakeling (GSS)
 - 6.1: De spanningsversterking
 - 6.2: De stroomversterking
 - 6.3: De ingangsimpedantie
 - 6.4: De uitgangsimpedantie
 - 6.5: Getallenvoorbeeld
- 7: De gemeenschappelijke gateschakeling (GGS)
 - 7.1: De spanningsversterking
 - 7.2: De stroomversterking
 - 7.3: De ingangsimpedantie
 - 7.4: De uitgangsimpedantie

- 7.5: Getallenvoorbeeld
- 7.6: Alternatieve DC-instelling: getallenvoorbeeld
- 8: De gemeenschappelijke drainschakeling (GDS)
 - 8.1: De spanningsversterking
 - 8.2: De stroomversterking
 - 8.3: De ingangsimpedantie
 - 8.4: De uitgangsimpedantie
 - 8.5: Getallenvoorbeeld
 - 8.6: De drainweerstand
- 9: Vergelijking tussen GSS, GGS en GDS
- 10: De bootstrapschakeling
- 11: De belastingsweerstand

Hoofdstuk 4: De MOSFET

- 1: De bouw van een MOSFET
 - 1.1: De N-kanaal verarmings MOSFET
 - 1.2: De P-kanaal verarmings MOSFET
 - 1.3: De N-kanaal verrijkings MOSFET
 - 1.4: De P-kanaal verrijkings MOSFET
- 2: De werking van een MOSFET
 - 2.1: De werking van een verarmings MOSFET
 - 2.2: De werking van een verrijkings MOSFET
 - 2.3: Combineren verarmings- en verrijkingsprincipe

- 3: Belangrijke opmerkingen
 - 3.1: Ruime toepasbaarheid
 - 3.2: Het beveiligen van een MOSFET
 - 3.3: Power MOSFET's
 - 3.4: Dual gate MOSFET's
- 4: MOSFET-versterkerschakelingen
 - 4.1: De DC-instelling van een MOSFET-schakeling
 - 4.2: De DC-instelling van een MOSFET-schakeling: oefening
 - 4.3: Laagfrequente MOSFET-versterkers
- 5: De MOSFET als schakelaar
 - 5.1: Principe
 - 5.2: Besluiten
 - 5.3: Opmerkingen
 - 5.4: Aansturen gate met behulp van een blokgolf

Hoofdstuk 5: Het Miller-effect

- 1: De feedback-capaciteit
 - 1.1: De ingangsimpedanties
- 2: De Miller-impedantie
 - 2.1: De condensatorstroom
 - 2.2: Het modelleren van de condensatorstroom
 - 2.3: Belangrijke opmerkingen
- 3: Voorbeelden en oefeningen

- 3.1: Laagfrequente versterkers met een zuivere weerstandsbelasting
- 3.2: De GES-schakeling
- 3.3: De GES-schakeling: getallenvoorbeeld
- 3.4: De GSS-schakeling
- 3.5: De GSS-schakeling: getallenvoorbeeld
- 4: Opmerkingen

Bibliografie

Bijlage1: Datasheets JFET

Bijlage 2: Datasheets MOSFET